

Мамандық бойынша тест: 1-пән

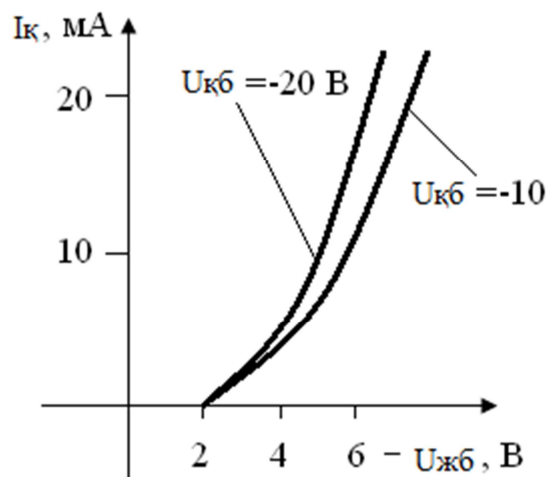
1. Жартылай өткізгіштерде жүретін диффузиялық $I_{\text{диф}}$ тоқты анықтау

- A) $I_{\text{диф}} = I_{\text{н. дрейф}} - I_{\text{т. диф}}$
- B) $I_{\text{диф}} = I_{\text{р. диф}} - I_{\text{н. диф}}$
- C) $I_{\text{диф}} = I_{\text{р. диф}} + I_{\text{н. диф}}$
- D) $I_{\text{диф}} = I_{\text{н. дрейф}} + I_{\text{н. диф}}$
- E) $I_{\text{диф}} = I_{\text{р. дрейф}} + I_{\text{р. дрейф}}$

2. Егерде $I_k = f(U_{кэ})$, бұл кезде $I_б = \text{const}$ болса онда ол

- A) транзистордың ортақ эмиттер (ОЭ) арқылы қосылған сұлбасының шығыс сипаттамасы
- B) транзистордың ортақ база (ОБ) арқылы қосылған сұлбасының шығыс сипаттамасы
- C) транзистордың ортақ база (ОБ) арқылы қосылған сұлбасының кіріс сипаттамасы
- D) транзистордың ортақ эмиттер (ОЭ) арқылы қосылған сұлбасының кіріс сипаттамасы
- E) транзистордың ортақ коллектор (ОК) арқылы қосылған сұлбасының кіріс сипаттамасы

3. Көрсетілген вольтамперлік сипаттамаларға тиісті транзистор



- A) индуцирленген арнасы бар МДЖ–транзистордың шығыс сипаттамасы
- B) басқарылатын pn –өткелді өрістік транзистордың беріліс сипаттамасы
- C) біріккен жаппасы бар МДЖ–транзисторының шығыс сипаттамалары
- D) индуцирленген арнасы бар МДЖ–транзистордың беріліс сипаттамасы
- E) біріккен жаппасы бар МДЖ–транзисторының беріліс сипаттамасы

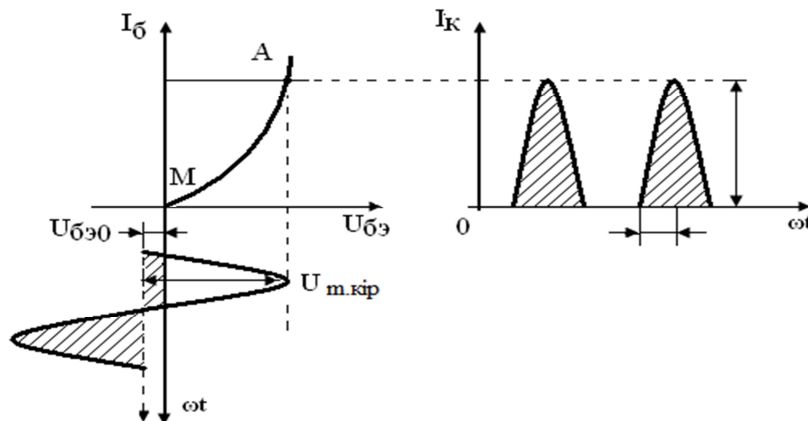
4. Потенциалдық тосқауыл – ол:

- A) негізгі заряд тасымалдаушылардың дрейфтік қозғалысына кедергі болатын магнит өрісі
- B) негізгі емес заряд тасымалдаушылардың диффузиялық қозғалысына кедергі болатын электр өрісі
- C) негізгі заряд тасымалдаушылардың диффузиялық қозғалысына кедергі болатын магнит өрісі
- D) негізгі заряд тасымалдаушылардың дрейфтік қозғалысына кедергі болатын электр өрісі
- E) негізгі заряд тасымалдаушылардың диффузиялық қозғалысына кедергі болатын электр өрісі

5. Транзистор кедейленген және байытылған режимдерде жұмыс атқаратын жартылай өткізгіш

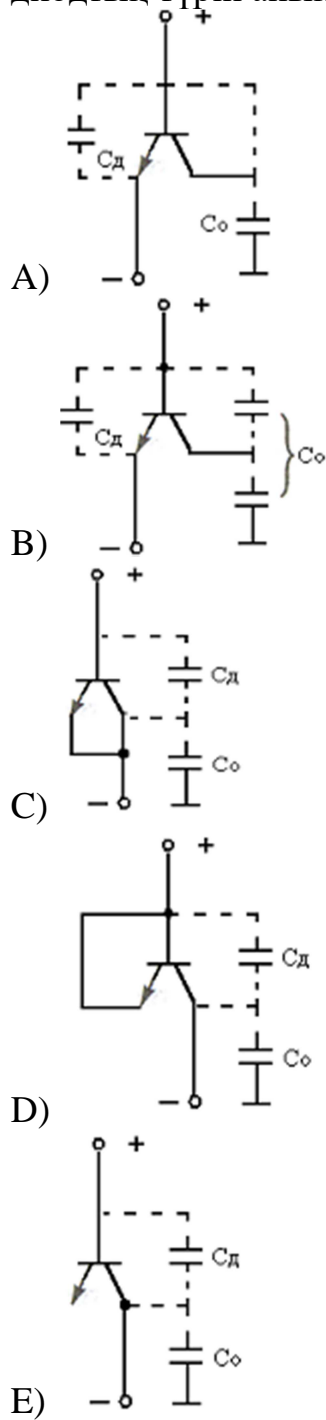
- A) Басқаратын p-n -өткелі бар өрістік транзисторы
- B) Біріккен каналды МДЖ-транзисторы
- C) Индукцияланған каналы барр-типті МДЖ-транзисторы
- D) Интегралды биполярлы транзисторы
- E) Индукцияланған каналы бар n-типті МДЖ-транзисторы

6. Суретте бейнеленген график бойынша күшейткіштің жұмыс істеу режимін анықтау



- A) B классы режимінде жұмыс істейтін күшейткіш
- B) D классы режимінде жұмыс істейтін күшейткіш
- C) A классы режимінде жұмыс істейтін күшейткіш
- D) C классы режимінде жұмыс істейтін күшейткіш
- E) AB классы режимінде жұмыс істейтін күшейткіш

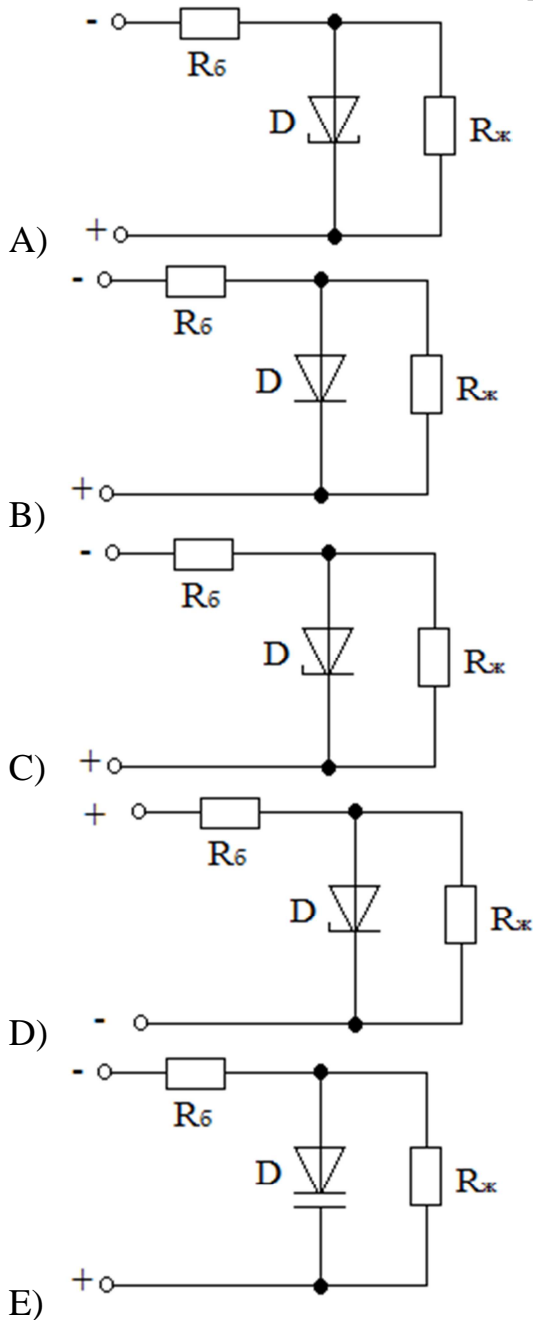
7. Б-Э (база-эмиттер) сұлбасы бойынша қосылған интегралды биполярлы диодтың түрін анықтау



8. Жартылай өткізгіштерде жүретін диффузиялық $I_{\text{диф}}$ тоқты анықтау

- A) $I_{\text{диф}} = I_{\text{н. дрейф}} - I_{\text{т. диф}}$
- B) $I_{\text{диф}} = I_{\text{р. диф}} - I_{\text{н. диф}}$
- C) $I_{\text{диф}} = I_{\text{р. диф}} + I_{\text{н. диф}}$
- D) $I_{\text{диф}} = I_{\text{н. дрейф}} + I_{\text{н. диф}}$
- E) $I_{\text{диф}} = I_{\text{р. дреф}} + I_{\text{р. дрейф}}$

9. Стабилитронды бейнелеген сұлба



10. Егерде $I_k = f(U_{кз})$, бұл кезде $I_6 = \text{const}$ болса онда ол

- A) транзистордың ортақ эмиттер (ОЭ) арқылы қосылған сұлбасының шығыс сипаттамасы
- B) транзистордың ортақ база (ОБ) арқылы қосылған сұлбасының шығыс сипаттамасы
- C) транзистордың ортақ база (ОБ) арқылы қосылған сұлбасының кіріс сипаттамасы
- D) транзистордың ортақ эмиттер (ОЭ) арқылы қосылған сұлбасының кіріс сипаттамасы
- E) транзистордың ортақ коллектор (ОК) арқылы қосылған сұлбасының кіріс сипаттамасы

